（部門共通・運要 5-1-5）

（公募掲載様式）

委員会委員公募掲載様式

委員会名 （所属部門）		パワーデバイス・パワーＩＣ技術調査専門委員会 （Ｃ部門） 【電子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要，委員長のメッセージ等 （100 字程度）
設置期間		平成 14 年 5 月～平成 17 年 3 月	本調査専門委員会では、大きく変貌しようとしているパワーデバイスの技術動向を探り、次世代に向けて取り組むべき課題を明らかにする。また、例えば特性限界に近づいたとされる MOSFET・IGBT などを中心に、今までの研究開発の歩みを振り返りまとめることを通して、今後の技術動向に重点を置いた調査研究を行なう。具体的な成果として、パワーデバイスハンドブックの改訂ならびに IGBT 単行本の出版を目標とする。
委員長名（所属）		関　康和（富士電機株式会社）	
委員会開催頻度		10 回／年	
問合・公募受付先	氏名 （所属）	岩室　憲幸 （富士日立ﾊﾟﾜｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ株式会社）	
	電話	0263-28-7167	
	FAX	0263-26-6945	
	E-mail アドレス	iwamuro-noriyuki@mmt.fujielectric.co.jp	
応募いただきたい方の専門分野，経験など		パワーデバイス・パワーＩＣの基礎、応用分野に従事され、今後の技術動向に興味をお持ちの方。電気学会の会員あるいは入会していただける方が望ましい。	
公募締切		平成 14 年 6 月 15 日	